精选快讯　硬件快讯　2026年11月13日 04:42

三星电子计划在Onyang量产HBM4E，封装厂2028年6月投产

要点

- 三星电子正推进Onyang芯片工厂扩建，以第七代HBM4E争取高带宽内存主导权，并延续当前推进HBM4的势头。
- HBM4E目前尚未量产。
- 继Onyang之后，三星电子还计划扩建Cheonan园区，建设一座28万平方米的HBM封装工厂，目标在明年年底完工。
- 三星电子同时宣布，将在忠清地区总计投资144万亿韩元建设新基础设施，包括Onyang HBM工厂以及OLED、AI芯片封装基板和下一代电池设施。

三星电子正推进Onyang芯片工厂扩建，以第七代HBM4E争取高带宽内存主导权，并延续当前推进HBM4的势头。位于Onyang园区的新HBM封装工厂将获得46万亿韩元投资，计划于2028年6月投产，配合新生产线于2028年投产并大幅扩大产能。执行会长反复强调在Onyang量产HBM4E的计划，动工仪式也重点突出该产品，期望其成为夺回HBM市场领先地位的关键。

HBM4E目前尚未量产。三星电子计划于明年上半年开始量产，并计划成为行业首家量产该产品的公司；该产品预计到2028年成为其旗舰产品。Onyang园区的产品展示中已加入尚未量产的HBM4E模型。执行会长表示，Onyang园区过去以传统芯片的简单封装和测试为中心，现在将转变为AI芯片核心——先进HBM的枢纽。

继Onyang之后，三星电子还计划扩建Cheonan园区，建设一座28万平方米的HBM封装工厂，目标在明年年底完工。公司计划与Giheung、Hwaseong、Pyeongtaek等附近DRAM生产基地加强协同，扩大HBM4、HBM4E以及预计2028年量产的HBM5的下一代HBM产能。

三星电子同时宣布，将在忠清地区总计投资144万亿韩元建设新基础设施，包括Onyang HBM工厂以及OLED、AI芯片封装基板和下一代电池设施。这一投资规模比7月作为大型项目计划一部分宣布的140万亿韩元多4万亿韩元。

报道来源：sedaily

来源网站：https://www.inews.today/